【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成18年11月30日(2006.11.30)

【公開番号】特開2005-54226(P2005-54226A)
【公開日】平成17年3月3日(2005.3.3)
【年通号数】公開・登録公報2005-009
【出願番号】特願2003-285451(P2003-285451)
【国際特許分類】
Ｃ２３Ｃ　18/48　(2006.01)
Ｃ２３Ｃ　18/18　(2006.01)
Ｈ０１Ｍ　8/04　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ２３Ｃ　18/48
Ｃ２３Ｃ　18/18
Ｈ０１Ｍ　8/04　Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成18年10月17日(2006.10.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
すなわち、本発明は、以下のとおりのものである。
（１）非導電性多孔質基材の表面に２０ナノメートル以下の金属パラジウムからなる種核を均一に析出させたのち、錯形成剤を含むパラジウムと銀の混合メッキ液で無電解メッキすることを特徴とする、非導電性多孔質基材へのパラジウムと銀の同時成膜方法。
（２）種核が１～２０ナノメートルの範囲のものである前記（１）記載の方法。
（３）種核を均一に析出させるのを、非導電性多孔質基材の表面にパラジウム錯体を均一に保持させたのち、還元することにより行う前記（１）又は（２）記載の方法。
（４）非導電性多孔質基材の表面にパラジウム錯体を均一に保持させるのを、非導電性多孔質基材にパラジウム錯体溶液を含浸させることにより行う前記（３）記載の方法。
（５）還元するのを、ヒドラジンを還元剤に用いて行う前記（３）又は（４）記載の方法。
（６）パラジウムと銀の混合メッキ液として、パラジウムと銀の総濃度が０．００５～０．０２Ｍ、銀塩とパラジウム塩との金属換算質量比（Ａｇ／Ｐｄ）が０．０１～０．５、アンモニア濃度が５～１０Ｍ、かつキレート剤濃度が０．０２～０．２Ｍであるものを用いる前記（１）ないし（５）のいずれかに記載の方法。
（７）パラジウムと銀の混合メッキ液として、パラジウムと銀の総濃度が０．００５～０．０２Ｍ、銀塩とパラジウム塩との金属換算質量比（Ａｇ／Ｐｄ）が０．０５～０．３、アンモニア濃度が５～１０Ｍ、かつＥＤＴＡ濃度が０．０５～０．１Ｍであるものを用いる前記（１）ないし（５）のいずれかに記載の方法。